

2014年12月10日
一般社団法人 新金属協会
化合物半導体部会
部会長 平野 立一
JX日鉱日石金属株式会社
電材加工事業本部 薄膜材料事業部
化合物半導体ユニット ユニット長

平成26年度上期の化合物半導体の出荷統計について

2014年度上期（2014年4月～2014年9月）の化合物半導体材料の出荷統計がまとまりましたので別紙の通り発表いたします。

2014年度上期（2014年4月～2014年9月）の化合物半導体製品の出荷額は、前年度比105%の157億円となり、対前年度で7億円の増加となった。結晶別では、主要3品目のうちGaP、InPが増加し、GaAsが前年並みとなった。用途別では電子デバイスで落ち込んでおり、前年度比82%となった。一方、可視LED、赤外LED及びLDはそれぞれ前年度比122%、116%、102%の伸びとなった。

1.GaAs

2014年度上期のGaAsの売上高は前年度並みとなった。地域別では輸出が前年同期比108%と増加したのに対し、国内市場は同81%と減少する結果となった。

GaAsの主な用途市場はスマートフォン等に使用される高周波デバイス、また各種の表示機器やセンサ等に使用される可視・赤外LED、およびDVD等に使用されるレーザダイオード（LD）等があるが、2014年度上期は主に赤外LEDの伸びがGaAs市場を牽引したものと推定している。

原料であるGaのロイター価格は足元、微減傾向となっている。

2.GaP

2014年度上期のGaPの売上高は前年度比137%となった。国内、海外ともに回復した。しかしながら、安価で高輝度な中国製AlInGaP系LEDへの置き換えの進行とGaP系LEDおよびGaAsP系LEDが車載、家電等の特定市場へ絞り込まれていく傾向は、今後も続くものと推察している。

3.InP

2014年度上期のInPの売上高は前年度比112%と増加した。InPの主要な用途は光通信用受発光素子である。スマートフォン等の情報端末、クラウドコンピューティング等の普及による通信量の増大を背景に、前年に引き続き光通信用部品の所要が堅調に推移した結果と推察している。

<お問い合わせ先>
JX日鉱日石金属株式会社
電材加工事業本部 薄膜材料事業部
化合物半導体ユニット 主席技師
中村 正志
電話 03-5299-7286 Fax 03-5299-7349
e-mail : masashi_nakamura@nmm.jx-group.co.jp